Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0203U008150

Державний реєстраційний номер: 0100U002860

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2003

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Іжнекційно-плазмові явища в неоднорідних напівпроводниках при дії зовнішніх факторів

Початок етапу: 01.2000

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0482) 23-84-17

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Інжекційно-плазмові явища в неоднорідних напівпровідниках при дії зовнішніх факторів

Назва роботи англійською:

Injection-plasma effectss at the nonhomogeneous semiconductors in the influence of the external factors

Реферат українською:

Створено концепцію інжекційно-плазмових явищ в неоднорідних напівпровідниках (нерівномірно-леговані і варизонні матеріали, поверхнево-бар'єрні структури) при дії зовнішніх факторів. Розроблено лабораторні моделі датчиків-сенсорів світла, магнітного поля, газів

Реферат англійською:

The concept of the injection-plasma effects at the nonhomogeneous semiconductors (nonuniformly - doping and graded band gap materials, fase - barrier structures) in the influence of the external factors was crestion. The laboratory models of the sensors of the light, magnetic field, gases are elaborated

Індекс УДК: 537.311.322, 621.382.4;537.311

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Курмашев Ш.Д.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1. Vikulin I., Vikulina L., Kurmashev Sh. Photodetectors with frequency out put on the base of unijunction and field-effect phototransistors//Photoelectronics. - 2002. - N. 10. - P. 51-55. 2. Курмашев Ш.Д., Викулин И.М. и др. Инжекция неосновных носителей заряда в поверхностно-баръерных структурах на основе Si:Au// Фотоэлектроника. - 2002. - Вып. 11. - С. 21-23. 3. Курмашев Ш.Д., Викулин И.М. и др. Спектральная фоточувствительность Ni-Si:Au поверхностно-баръерных структур ижекционным усилением // ТКЭА. - 2002. - № 6. - С. - 72-74

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Сминтина В. А.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

